



Toshiba Memory Europe stellt UFS-Bausteine mit 64-Layer 3D-Flash-Speicher vor

Düsseldorf, 29. November 2017 – Toshiba Memory Europe GmbH bietet ab sofort Muster seiner UFS-Bausteine (Universal Flash Storage)^[1] auf Basis des 64-Layer BiCS FLASH™ 3D-Flash-Speichers^[2] von Toshiba Memory Corporation an. Die neuen Speicher eignen sich für Anwendungen, die eine schnelle Lese-/Schreibleistung und einen geringen Stromverbrauch erfordern, darunter Mobilgeräte wie Smartphones und Tablets sowie AR-/ VR-Systeme (Augmented/Virtual Reality).

Die neue Serie wird in vier Kapazitäten erhältlich sein: 32, 64, 128 und 256GB^[3]. Alle Bausteine verfügen über Flash-Speicher und einen Controller in einem 11,5 mm x 13 mm Gehäuse entsprechend dem JEDEC-Standard. Der Controller führt eine Fehlerkorrektur, Wear-Leveling, eine Übersetzung logischer auf physikalische Adressen und eine Bad-Block-Verwaltung durch, was sich die Systementwicklung vereinfacht.

Alle vier Speicher entsprechen der JEDEC UFS Ver2.1, einschließlich HS-GEAR3, die eine theoretische Schnittstellengeschwindigkeit von bis zu 5,8Gbit/s pro Lane (x2 Lanes = 11,6 Gbit/s) ermöglicht und einen höheren Stromverbrauch verhindert. Die sequentielle Lese- und

Schreibleistung^[4] des 64GB-Bausteins beträgt 900 bzw. 180 MB/s, während die zufällige Lese- und Schreibleistung um 200 bzw. 185 % höher ist als bei Speichern der vorherigen Generation^[5]. Durch seine serielle Schnittstelle unterstützt UFS Vollduplex-Übertragung, was gleichzeitiges Lesen und Schreiben zwischen dem Host-Prozessor und UFS-Baustein ermöglicht.

Anmerkungen:

* Die hier erwähnten Firmen-, Produkt- und Servicennamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.

[1] Universal Flash Storage (UFS) ist eine Produktkategorie für eine Klasse von Embedded-Speichern, die nach der UFS-Standardspezifikation der JEDEC entwickelt wurde.

[2] Muster des 64GB-Bausteins stehen ab sofort zur Verfügung; die restlichen Bausteine der Serie folgen im Dezember.

[3] Die Bausteindichte wird anhand der Speicherchipdichte(n) innerhalb des Bausteins und nicht anhand der Speicherkapazität für die Datenspeicherung durch den Endbenutzer ermittelt. Die vom Benutzer nutzbare Kapazität ist aufgrund von Overhead-Datenbereichen, Formatierung, fehlerhaften Blöcken und anderen Einschränkungen geringer und kann je nach Host und Anwendung variieren. Einzelheiten finden sich in den Produktspezifikationen.

[4] Lese- und Schreibgeschwindigkeiten werden mit 1MB/s = 1.000.000 Byte/s berechnet. Die tatsächliche Lese- und Schreibgeschwindigkeit hängt vom Baustein, den Lese- und Schreibbedingungen und der Dateigröße ab.

[5] Vorgänger des 64GB-Bausteins von Toshiba Memory Corporation: THGAF4G9N4LBAIR

###

Über Toshiba Memory Europe

Toshiba Memory Europe GmbH (TME) ist die europäische Niederlassung der Toshiba Memory Corporation (TMC). Das Unternehmen bietet eine umfangreiche Auswahl an hochwertigen Flash-Speichern, darunter SD Cards, USB Sticks, micro SDs und Embedded-Speicherbausteine, zusätzlich zu Solid State Drives (SSD). TME unterhält Niederlassungen in Deutschland, Frankreich und Großbritannien. Masaru Takeuchi ist der Präsident des Unternehmens.

Weitere Informationen über das Speicherangebot und die SSDs von TME unter <http://toshiba.semicon-storage.com>

Ansprechpartner für Veröffentlichungen:

Toshiba Memory Europe GmbH, Hansaallee 181, 40549 Düsseldorf, Germany

Tel: +49 (0) 211 5296 0 Fax: +49 (0) 211 5296 79197

E-mail: support@toshiba-memory.com

Ansprechpartner für die Presse:

Philipp Schiwiek, Toshiba Memory Europe GmbH

Tel: +49 (0) 211 36877 319

E-mail: pschiwiek@toshiba-tme.eu

Herausgegeben durch:

Birgit Schöniger, Publitek

Tel: +44 (0) 20 8429 6554

E-mail: birgit.schoeniger@publitek.com

Web: www.publitek.com

November 2017

Ref. TME001/A